

研究工作报道

高气压紫外预电离横向放电泵浦 XeCl 激光器*

陈建文 傅淑芬 刘妙宏

(中国科学院上海光学精密机械研究所)

目前，在稀有气体卤化物准分子激光器领域里，正掀起一股研究 XeCl 激光器的热潮^[1-6]。这不仅因为 XeCl 具备准分子的一切特点：辐射波长处于紫外区，能量转换效率高，可调谐，能够高重复率运转，而且工作寿命长，所使用的氯化物品种多，因此，这种激光器具有很大的实用价值。它正在吸引着越来越多的研究者。Burnham 等^[7]和 Sze 等^[8]采用 HCl 作氯施主，总气压在三个大气压以上，能量转换效率达 1%，Northrop 研究和技术中心，在 1 升火花预电离装置上获得 180 毫焦耳输出。这些结果可以和 KrF 相媲美。

我们曾以 BCl_3 ^[9]， CCl_4 和 CHCl_3 作为氯施主，在一个大气压以下，以电晕预电离方式，成功地获得了 XeCl 激光器的相干辐射。

本文报道的是高气压紫外预电离横向放电泵浦 XeCl 激光器的实验结果。实验装置和等效电路分别示于图 1 和图 2。

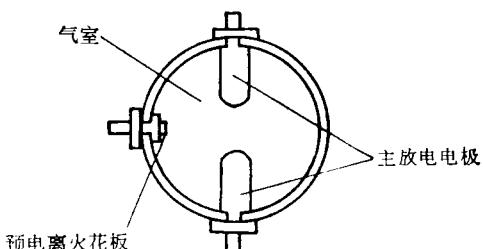


图 1 实验装置简图

一对黄铜电极长为 70 厘米，间距为 2 厘米，被安装在内径为 87 毫米的圆筒形气室内。光学谐振腔直接装在圆筒的两端，一端是 $R = 3$ 米的全反射铝镜，一端是石英平板。主放电电路由平行平板电容器 $C_1 = 16 \times 10^{-9}$ 法拉，

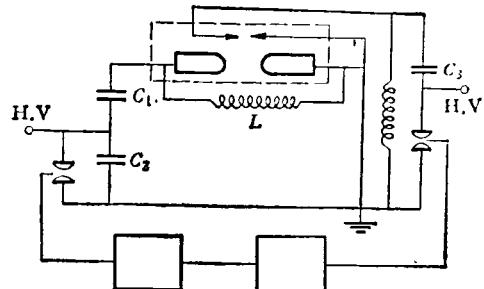


图 2 XeCl 激光器等效电路

$C_2 = 8 \times 10^{-9}$ 法拉及小电感 L 组成。预电离由 28 个火花隙构成，由一商品瓷介电容器 C_3 供电， $C_3 = 10 \times 10^{-9}$ 法拉。主放电和预电离由延时触发器控制，延时范围为 0—1 微秒可调。

当以气分比： $\text{HCl} : \text{Xe} : \text{He} = 0.2\% : 5\% : 94.8\%$ 充入两个大气压的混合气体时，主放电用 20 千伏的电压，预电离用 18 千伏的电压，获得最大能量输出为 43 毫焦耳，体能量密度为 3 焦耳/升，总效率为 1.4%。若不加上预电离，放电室内充满弧光，振荡熄灭。

这里要指出的是，以 CCl_4 作氯施主时，紫外预电离效果较差，这可能是由于多原子分子吸收紫外预电离光子，因而输出也明显低于以 HCl 作氯施主的相干辐射。

图 3 是用 31 W II 两米光栅光谱仪摄得的 XeCl 激光谱。无论在 $\text{CCl}_4 : \text{Xe} : \text{He}$ 体系中，还是在 $\text{HCl} : \text{Xe} : \text{He}$ 混合体系中，辐射谱线与氯施主材料无关。实验表明，辐射谱线的数目取决于总气压。

* 1979 年 7 月 30 日收到。

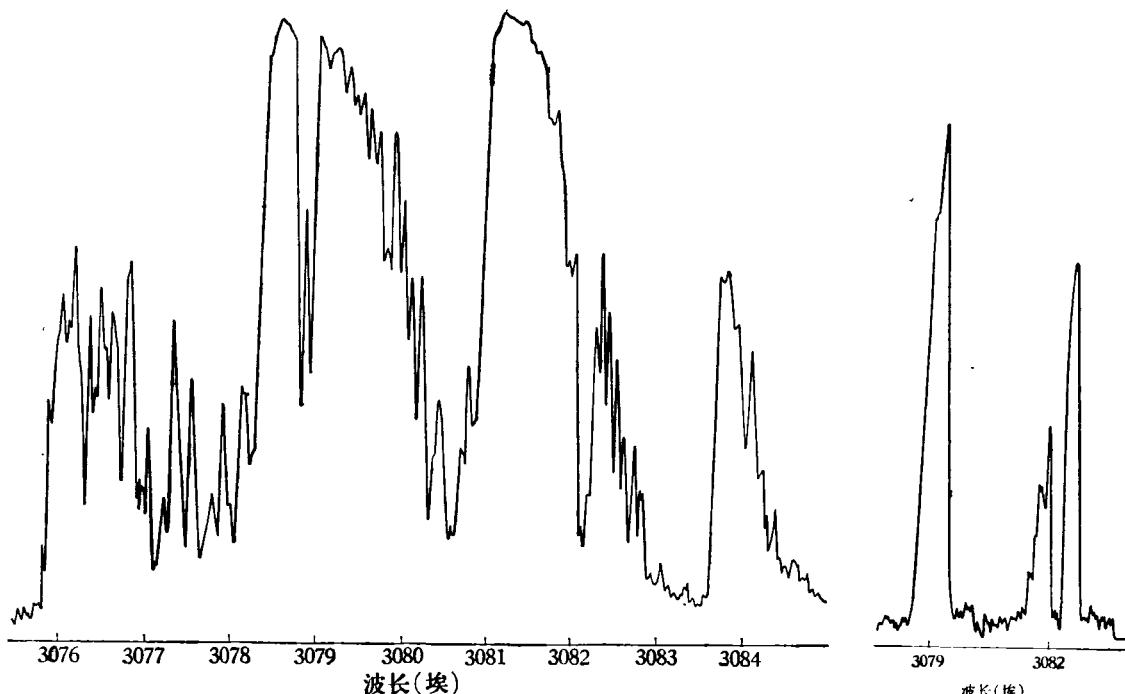
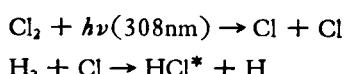


图 3(a) 总气压为 500 托时的 XeCl 激光谱

图 3(b) 总气压为两个大气压时的 XeCl 激光谱

总气压为 500 托时, 有六个振动带同时受激辐射, 谱线数目约 100 条左右; 在两个大气压时, 辐射谱只有三条。显然, 这是由于气压增高, 分子间碰撞次数增多, 从而使激发态高振动带上粒子弛豫到低振动能级, 以致高振动带对应的反转粒子数密度满足不了阈值条件, 所以辐射谱线显著减少。

我们还观察了 XeCl 激光器的工作寿命, 无论采用 HCl 或 CCl₄ 作氯施主, 一次充气激射五千次, 输出降低到初始值一半。而在同样装置上, XeF, KrF, KrCl 仅激射几百次, 辐射便停止。这是 XeCl 激光器所特有的优点。这可能是由于在放电室内存在着 Cl₂ 和 H₂, 并有下列反应:



尽管放电后 HCl 含量减少, 但 XeCl 的 308 毫微米辐射对 Cl₂ 光离解截面相当大, 使 Cl₂ 离解成为 Cl + Cl, 保证在放电室内有一定浓度的 HCl, 延长了激射寿命。

在上述装置上, 我们以 HCl:Kr:He, NF₃:

Ar:He 混合气体, 分别获得了 2221 埃的 KrCl 和 1933 埃的 ArF 激光输出。当充以 3 托的空气和两个大气压的 He 气时, 还获得了 4278 埃的 N₂⁺ 激光输出。这些激光器的特性将另文发表。

参 考 文 献

- [1] V. N. Ishechenko et al., *Opt. Commun.*, **21**(1977), 30.
- [2] J. I. Levatter et al., *A. P. L.*, **32**(1978), 630.
- [3] L. F. Chanpagne, *A. P. L.*, **34**(1979), 315.
- [4] L. Burlamacchi, *A. P. L.*, **34**(1979), 33.
- [5] R. E. Rotho et al., *IEEE J. Q. E.*, **QE-15**(1979), 314.
- [6] R. Burnham, *Opt. Lett.*, **3**(1978), 215.
- [7] R. Burnham et al., *Opt. Commun.*, **24**(1978), 161.
- [8] R. C. Sze et al., *A. P. L.*, **33**(1978), 419.
- [9] 傅淑芬、陈建文等, 物理, **7**(1978), 348.